第二十二讲 材料中的相变

主讲人:张骞

材料科学与工程学院

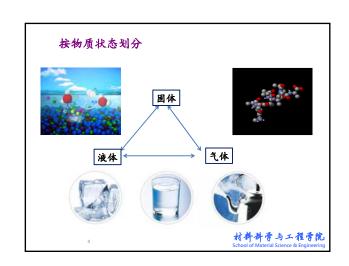


相变的分类

分类方法有很多,目前有以几种:

- 一、按物质状态划分
- 二、从热力学角度划分
- 三、按相变发生的机理来划分

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering



从热力学角度划分:

根据相变前后热力学函数的变化,可将相变分为一级 相变、二级相变和高级相变。

1.一级相变:在临界温度、压力时,化学位的一阶 偏导数不相等的相变。

两相能够共存的条件是化学位相等。

$$\mu_1 = \mu_2$$

相变时:体积V,熵S,热焓H发生突变

$$\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial T}\right)_{P} \neq \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial T}\right)_{P} \qquad \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial P}\right)_{T} \neq \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial P}\right)_{T}$$

$$\left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial T}\right)_{\boldsymbol{P}} = -\overline{S} \qquad \left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \boldsymbol{P}}\right)_{\boldsymbol{T}} = \overline{\boldsymbol{V}}$$

一般熔化, 蒸发,升华相变属于这

材料科学与工程学院

2二级相变:在临界温度、临界压力时,化学位的一阶 偏导数相等,而二阶偏导数不相等的相变。

$$\mu_1 = \mu_2$$
 $\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial T}\right)_{P} = \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial T}\right)_{P}$ $\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial P}\right)_{T} = \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial P}\right)_{T}$

因为:恒压热容
$$\left(\frac{\partial^2 \mu}{\partial T^2}\right)_P = -\frac{C_P}{T}$$
 材料压缩系数

材料压缩系数

$$\left(\frac{\partial^{2} \boldsymbol{\mu}}{\partial \boldsymbol{P}^{2}}\right)_{T} = -V\boldsymbol{\beta} \qquad \boldsymbol{\beta} = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial \boldsymbol{P}}\right)_{T}$$

材料体膨胀系数

$$\frac{\partial^2 U}{\partial T \partial P} = V \alpha \qquad \alpha = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

所以二级相变时,系统的化学势、体积、熵无突变,

$$\Delta C_{P} \neq 0$$

$$\Delta \beta \neq 0$$

$$\Delta \alpha \neq 0$$

一般合金的有序-无序 相变,磁转变,超导 转变属于这一类。

所以热容、热膨胀系数、压缩系数均不连续变化,即发生实变。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

3. 高级相变:

在临界温度,临界压力时,一阶,二阶偏导数相等, 而三阶偏导数不相等的相变成为三级相变。

实例:量子统计爱因斯坦玻色凝结现象为三级相变。 依次类推,自由焓的n-1阶偏导连续,n阶偏导不连续 时称为高级相变。二级以上的相变称为高级相变, 一般高级相变很少,大多数相变为低级相变。

> 材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

按照动力学分类

✓按照原子迁移特征分

- 扩散型相变
- 无扩散型相变

✓按结构变化即转变速度快慢分

- 重构型相变
- 位移型相变

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

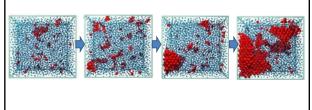
按相变发生的机理分类

- 1、成核-生长机理
- 2、斯宾那多分解
- 3、马氏体相变
- 4、有序-无序转变

材料科学与工程学院

成核-生长机理是最重要最普遍的机理

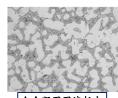
许多相变是通过成核与生长过程进行的。这两个过程都需活化能。如,单晶硅的形成、溶液中析晶等。

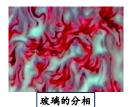


材料科学与工程学院

斯宾那多分解

又称为不稳定分解,拐点分解或旋节分解,是由于组成起伏引起的热力学上的不稳定性而产生的。





合金凝固固溶析出

表1 两种相变机理的主要差别		
	亚 稳	不 稳
成 分	第二相组成不随时间变化	第二相组成随时间而连续向两个极端组成 变化,直至达到平衡组成
形 貌	第二相分离成孤立的球形颗粒	第二相分离成有高度连续性的非我形颗粒
有 序	颗粒尺寸和位置在母液中是无序的	第二相分布在尺寸上和间距上均有规则
界面	在分相开始界面有突变	分相开始界面是弥散的逐渐明显
能 量	分相需要位垒	不存在位垒
扩散	正扩散	负扩散
时 间	分相所需时间长	分相所需时间极短
	动力学障碍大	动力学障碍小
材料計画与工程学院 School of Material Science & Engineering		

马氏体相变

马氏体相变最早在中,高碳钢冷淬火后被发现,将钢 加热到一定温度(形成奥氏体)后经迅速冷却(淬火) 即会使钢变硬,增强。这种淬火组织具有一定特征,称 其为马氏体。最早把钢中的奥氏体转变为马氏体的相变 称为马氏体相变。后来发现纯金属和合金也具有马氏体

相变。



材料科学与工程学院

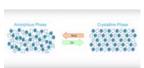
有序—无序相变:

旧相和新相结构只是对称性的改变,相变过程以有 序参量表征的相变。

有序 - 无序的转变是固体相变中的另一种机理, 属扩散性相变。如尖晶石结构的磁性体Fe₃O₄,室温 下Fe³⁺Fe²⁺无序排列,但在120K以下,Fe³⁺Fe²⁺占具 各自的位置呈有序排列,有序-无序转变的温度称居





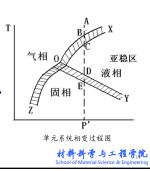


材料科学与工程学院

相变过程的不平衡状态及亚稳区

- · 亚稳区 :理论上应发生相变而实际上不能发生相转变的区域
- 如下图所示的阴影区。
- 需过冷、过饱和才能相变。

- (1) 亚稳区具有不平衡状态的特征, 是物相在理论上不能稳定存在,而实际 上却能稳定存在的区域;
- (2)在亚稳区内,物系不能自发产生 新相,要产生新相,必然要越过亚稳区, 这就是过冷却的原因;
- (3)在亚稳区内虽然不能自发产生新 相,但是当有外来杂质存在时,或在外 界能量影响下, 也有可能在亚稳区内形 成新相, 此时使亚稳区缩小。



相变过程推动力

· 总的推动力:相变过程前后自由能的差值

1、相变过程推动力---相变过程的温度条件

在等温等压下、ΔG=ΔH-TΔS

在平衡条件下, $\Delta G=0$, 则 $\Delta S=\Delta H/T_0$

在任意一温度的不平衡条件下,则有△G=△H-T△S≠0

若ΔH与ΔS不随温度而变化,

 $\Delta G = \Delta H - T \Delta H / T_0 = \Delta H (T_0 - T) / T_0 = \Delta H \Delta T / T_0$

- ✓ 相变过程放热 Δ H<0, 要使 Δ G<0, 须有 Δ T>0, T<T $_{0}$, 过冷;
- √ 相变过程吸热 ΔH>0,要使 ΔG<0,须有 ΔT<0,T>T₀, 过热。

因此相平衡理论温度与系统实际温度之差即为该相变过程的 推动力。

材料科学与工程学院

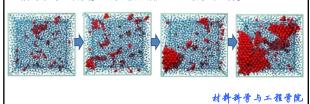
2 相变过程推动力--相变过程的压力和浓度条件

- 1、气相,恒温下 G=RT hP₀/P 欲使 G <0,须P>P₀ 即汽相过饱和。
- · 2、溶液, ΔG=RTInCo/C 欲使 ΔG <0,须C>Co 即液相 过饱和 。

综上所述,相变过程的推动力应为过冷度、过饱和浓度、 过饱和蒸汽压。即相变时系统温度、浓度和压力与相平衡时 温度、浓度和压力之差值。

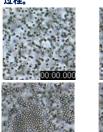
成核-生长相变

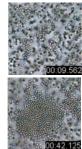
大多数相变过程都具有成核。生长相变机理。 大量的晶型转变包括简单地分解为二相区域的转变,都可以用成核。生长过程来描述。 在这种过程中,新相的核以一种特有的速率 先形成,接着这个新相再以较快的速度生长。 亚稳相到稳定相的不可逆转变。 通常是以成核。生长的方式进行。



三、熔体中的析晶过程

在熔点以下的温度下长时间保温,物系一般都会依据成核—生长相变机理析晶,最终都会变成晶体。结晶包括成核和长大两个过程。下面从热力学和动力学两个方面介绍结晶的成核和长大两个







晶核形成条件

・ 当一个熔体(熔液)冷却发生相转变时,则系统由一相变成两相,这就使体系在能量上出现两个变化,一是系统中一部分原子(离子)从高自由能状态(例如液态)转变为低自由能的另一状态(例如晶态),这就使系统的自由能减少(G_1);另一是由于产生新相,形成了新的界面(例如固一液界面),这就需要作功,从而使系统的自由能增加(G_2)。因此系统在整个相变过程中自由能的变化(G)应为此两项的代数和。

$$\triangle G = \triangle G_1 + \triangle G_2 = V \triangle G_V + A_Y$$

若假设生成的新相晶胚呈球形,则 $\Delta G=4/3\pi r^3 \cdot n \cdot \Delta Gv+4\pi r^2 \cdot n \gamma$

材料科学与工程学院

|• ΔG=4/3πr³·n·ΔHΔT/T₀+4πr²·nγ

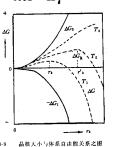
见下图表示△G与晶胚 半径r的关系

通过求曲线的极值来确定晶体 的临界半径:

 $d(\Delta G)/dr = 4\pi r^2 \cdot n \cdot \Delta H \Delta T/T_0 + 8\pi r \cdot n\gamma = 0$ $r^* = -\Delta H \Delta T 2\gamma T_0/\Delta H \Delta T = -2\gamma/\Delta G_v$

由此得出:

- · 1. r*愈小,新相愈易形成。
- 2. 因为γ、T₀均为正值,析晶 放热过程ΔH(0, 所以 ΔT>0。
- · 3. 降低γ、增加ΔH均有利于析晶。



解(据 Mullin, 1972)

材料科学与工程学院

4. 相应于rk时的自由能变化为:

 $\Delta G_{r^*}\!\!=\!\!32\pi n\gamma^3/3\Delta G_V^2\!\!+\!16\pi n\gamma^3/\Delta\,G_V^2$

- = $\frac{1/3 (16\pi n \gamma^3/\Delta G_V^2)}{=1/3 A_{r*} \gamma}$
- $-1/3A_{r*}\gamma$
- 5、达r*晶胚数目:

 n_{r*} =nexp (- $\Delta G_{r*}/RT$)

材料科学与工程学院

液—固相变过程动力学

材料科学与工程学院

4

均态核化速率I

成核过程就是熔体中一个个原子加到临界核胚上,临界核胚就能成长为晶核。

核化速率表示单位时间内单位体积的液相中生成的晶核数 目,用I表示。

核的生成速率取决于单位体积液体中的临界核胚的数目 $(n, \dot{},)$ 以及原子加到核胚上的速率(即单位时间到达核胚表面的原子数 (n_s) 及与临界核胚相接触的原子数 (n_s) 。

成核速率 I= 单位体积液体中临界核胚数 × 与临界尺寸的核相接触的原子数 × 单个原子与临界尺寸的核相撞而附于其上的频率。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

单位体积液体中的临界核胚的

数目:

$$n_r^* = n \exp(-\frac{\Delta G_r^*}{RT})$$

式中n一单位体积中原子或分 子数目

单位时间单个原子跃迁到临界 核胚表面的频率:

$$g = a\gamma_0 \exp(-\frac{\Delta G_a}{RT})$$

式中a为常数:原子在核胚方向振动的频率;

设环绕临界核胚的周围的界面里,有n_s个原子。

因此,成核速率|可写成:

$$I = n_r^* \bullet n_s \bullet q$$

$$= n \exp(-\frac{\Delta G_r^*}{RT}) \bullet n_s \bullet a \gamma_0 \exp(-\frac{\Delta G a}{RT})$$

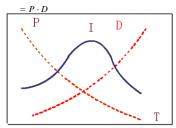
$$= B \exp(-\frac{\Delta G_r^*}{RT}) \exp(-\frac{\Delta G a}{RT})$$

$$= P \cdot D$$

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

下图,只有在合适的过冷度下, I_u有最大值。

$$I = B \exp(-\frac{\Delta G_r^*}{RT}) \exp(-\frac{\Delta G_a}{RT})$$



成核速度I与温度关系图

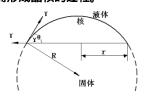
材料科學与工程學院 School of Material Science & Engineering

非均匀成核

非均匀成核是指借助于表面、界面、微粒裂纹、 器壁以及各种催化位置等而形成晶核的过程。

成核前后系统的自由能的 变化为:

 $\Delta G_h = \Delta G_V$, (-) $+\Delta G_S$ (+)



材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

Gs:

假设核的形状为球体的一部分,其曲率半径为R,核在固体界面上的半径为r,液体 - 核(LX)、核 - 固体((S))和液体 - 固体((S))的界面能分别为 $_{LX}$ 、 $_{XS}$ 和 $_{LS}$,液体 - 核界面的面积为 $_{LX}$,形成这种晶核所引起的界面自由能变化是:

$$G_{S} = L_X A_{LX} + r^2 (\chi_{S} - L_s)$$



材料科学与工程学院

当形成新界面LX 和X S时,液固界面(LS)减少 $^{\rm P}$ 。假如 $_{\rm LP}$ $_{\rm XS}$,则 $_{\rm G}$ $_{\rm S}$ 小于 $_{\rm LX}$ · $_{\rm A}$ $_{\rm LX}$,说明在固体上形成晶核所需的总表面能小于均匀成核所需要的能量。接触角 和界面能的关系为

 $cos = (_{Ls}-_{XS})/_{LX}$

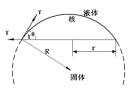
得到:

G_S= _{LX}A_{LX}- r² _{Ls} ωs 其中:球缺的表面积

 $A = 2\pi R^2 (1 - \cos \theta)$

与固体接触面的半径

 $r = R \sin \theta$



G_v':

 G_V '=V G_V

图中假设的球缺的体积:

$$V = \pi r R^3 \frac{2 - 3\cos\theta + \cos^3\theta}{3}$$

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

 $\Delta G_h = V \Delta G_V + \gamma_{LX} A_{LX} - \pi r^2 \gamma_{LX} \cos \theta$

令 $d(G_h)/dR=0$,得出不均匀成核的临界半径

$$R^* = -\frac{2\gamma_{LX}}{\Delta G_V}$$

非均态核化势垒 :

$$\Delta G_h^* = \frac{16\pi \gamma_{LX}^3}{3(\Delta G_V)^2} \frac{(2 + \cos\theta)(1 - \cos\theta)^2}{4} = \Delta G_r^* f(\theta)$$

可见,在成核基体上形成晶核时,成核位垒应随着接触 角的减小而下降。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

• 非均匀晶核形成速率为:

 $I_S = K_S \exp(-\Delta G_h^* / RT) \exp(-\Delta G_m / RT)$

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

6